

項目	測定方法	単位		窒化ケイ素 (Si ₃ N ₄)
				TSN-90
密度	JIS Z8807	常温	g/cm ³	3.35
比熱	JIS C2141		J/kg·K	650
熱伝導率	JIS R1611		W/m·K	90
熱膨張係数	JIS C2141	常温~500℃	x10 ⁻⁶ /K	3.4
絶縁耐力	JIS C2110-1	50Hz	kV/mm	25
体積固有抵抗	JIS C2141	常温	Ω·cm	1x10 ¹⁵
比誘電率	JIS C2141	1MHz		8
誘電損失	JIS C2141	1MHz	tanδx10 ⁻⁴	8
3点曲げ強度	JIS C2141	常温	MPa	680
破壊靱性値	JIS R1607	常温	MPa·m ^{1/2}	6.5
ヤング率	JIS R1602	常温	GPa	300
ポアソン比	JIS R1602			0.27
特長				高熱伝導 高強度
主な推奨用途				半導体実装用基板 (圧接用)放熱板 ヒートシンク

上表の値は参考値であり、保証値ではありません。